

Übungen zur Festkörperphysik I

Serie 8: Transport in Metallen

Verteilung: 12.12.2006

Abgabe: 20.12.2006

Rückgabe: 3.1.2007

Kurzfragen

- Was versteht man unter dem Drude-Modell?
- Welche Streuprozesse für Elektronen in einem Metall kennen Sie? Wie äussern sich diese Streuprozesse im Temperaturverlauf des elektrischen Widerstandes?
- Definieren Sie den Wärmeleitkoeffizienten der Metalle in Analogie zur elektrischen Leitfähigkeit. Welchen Zusammenhang zwischen den beiden Grössen gibt es?
- Wie kann man die Zustandsdichte am Fermi-niveau in einem Metall messen?

1 Änderung der Besetzung der Fermikugel durch ein elektrisches Feld

Legt man ein elektrisches Feld E_x an ein Metall an, so ergibt sich im thermischen Gleichgewicht eine neue Verteilungsfunktion $f_1(k)$. Diese ergibt sich unter vernünftigen Voraussetzungen (d.h. nicht allzu grosse E_x) aus dem ursprünglichen Fermikörper $f_0(k)$ durch Verschiebung:

$$f_1(k) = f_0(k - \delta k)$$

Für ein Metall trägt aber nur die Elektronenkonzentration δn nahe der Fermikante zum Stromtransport bei, nicht die gesamte Elektronenkonzentration n_e . Um eine Vorstellung von der Grösse $n_e/\delta n$ zu erhalten, betrachten wir die Fermikugel mit Volumen V_k , die durch das elektrische Feld um δk verschoben wird. Das über die ursprüngliche Fermikugel hinaus verschobene Volumen sei δV_k . Begründen Sie die Relation

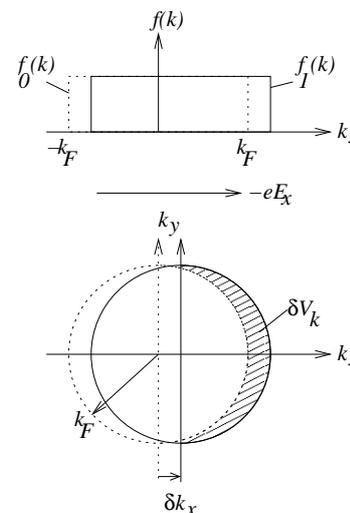
$$\frac{n_e}{\delta n} \approx \frac{V_k}{2\delta V_k}$$

- Zeigen Sie, dass für kleine Verschiebungen gilt:

$$\frac{V_k}{2\delta V_k} \approx \frac{2k_F}{3\delta k} = \frac{2v_F}{3v_D}$$

Hinweis: Eine Kugelkalotte des Radius R und der Höhe $h = (R - x)$ hat für $x \ll R$ das Volumen $\frac{2}{3}\pi R^3 - \pi x R^2$

- Ermitteln Sie das Verhältnis $n_e/\delta n$ für Silber ($\tau = 2 \cdot 10^{-13}$ s, $n_e = 5.86 \cdot 10^{28}$ m⁻³) für ein Feld von $E_x = 0.1$ V/m.



2 Halbmetall

Ein Halbmetall ist durch einen teilweisen Bandüberlapp charakterisiert. Die Leitfähigkeit des typischen Halbmetalls Bi ($\sigma = 8.6 \cdot 10^5 \text{ } (\Omega\text{m})^{-1}$) ist immer noch sehr viel kleiner als die des typischen Metalls Na ($\sigma = 2.1 \cdot 10^7 \text{ } (\Omega\text{m})^{-1}$). Wie beim Halbleiter, entstehen beim Übergang von Elektronen aus Zuständen des unteren in solche des oberen Bandes, Löcher im unteren Band.

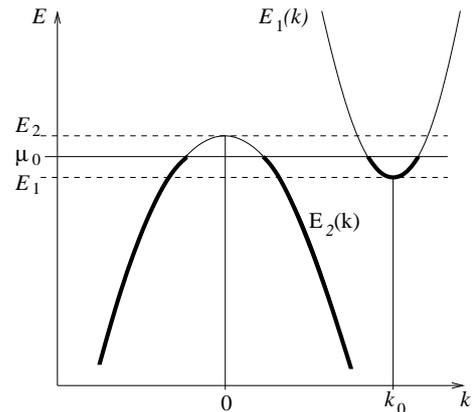
Wir benutzen folgendes Modell des Halbmetalls:

$$E_1(k) = E_1 + \frac{\hbar^2}{2m_1}(k - k_0)^2$$

$$E_2(k) = E_2 - \frac{\hbar^2}{2m_2}k^2$$

$$m_1 = 0.06m_e$$

$$m_2 = 0.18m_e$$



Der Überlapp beträgt $E_1 - E_2 = 0.1 \text{ eV}$. Hier ist $E_{1,2}$ die Energie des unteren bzw. des oberen Randes von Band 1 bzw. 2. Bestimmen Sie den Abstand $(\mu_0 - E_1)$ des chemischen Potentials vom unteren Rand des Bandes 1 bei $T = 0 \text{ K}$.

Hinweis: Das chemische Potential ergibt sich aus der Neutralitätsbedingung.

3 Zyklotronresonanz der Leitungselektronen

In einem Magnetfeld $B||z$ ergeben sich die Energieeigenwerte freier Elektronen nach Landau zu

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c + \frac{\hbar^2}{2m}k_z^2 \quad (1)$$

- Leiten Sie klassisch einen Ausdruck für die hier auftretende Zyklotronfrequenz ω_c freier Elektronen her.
- Für den Halbleiter InSb beträgt die effektive Masse der Leitungselektronen $m^* = 0.014m_e$. Wie gross muss das Magnetfeld B sein, damit die Leitungselektronen durch Einstrahlung von Mikrowellen der Wellenlänge $\lambda = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ zur Zyklotronresonanz angeregt werden?